АСИММЕТРИЧНЫЙ ЭФФЕКТ БОРМАНА В ПАССИВНОМ РТ-СИММЕТРИЧНОМ ФОТОННОМ КРИСТАЛЛЕ

В. А. Бушуев^{*}, Б. И. Манцызов^{**}

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова 119991, Москва, Россия

> Поступила в редакцию 29 апреля 2022 г., после переработки 25 мая 2022 г. Принята к публикации 25 мая 2022 г.

Аналитическим спектральным методом решена граничная задача динамической брэгговской дифракции оптического излучения в геометрии Лауэ в одномерном пассивном РТ-симметричном фотонном кристалле (ФК). Показано, что эффект Бормана, или аномально высокая прозрачность кристалла при выполнении брэгговского условия, в пассивном РТ-симметричном ФК имеет ряд особенностей, которые объясняются наличием особой точки спонтанного распада РТ-симметричных компонент мод излучения. Так, при эффекте Бормана увеличивается амплитуда дифрагированной волны за счет роста поглощения среды. Это наблюдается в окрестности особой точки выше порогового значения параметра поглощения при положительном брэгговском угле падения излучения на кристалл. Имеет место также асимметрия эффекта Бормана в пассивном РТ-симметричном ФК: амплитуда дифрагированной волны меняется при смене знака угла Брэгга — увеличивается в случае отрицательного угла падения.

DOI: 10.31857/S0044451022090048 **EDN:** EKDNPV

1. ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие концепция PTсимметрии (parity-time symmetry), предложенная впервые в квантовой механике для неэрмитовых систем [1–3], вызывает большой интерес в оптике неконсервативных сред, в которых оптические свойства характеризуются РТ-симметрией [4-7]. Диэлектрическая проницаемость в таких средах с усилением и поглощением описывается РТсимметричной комплексной функцией координаты $\varepsilon(x) = \varepsilon^*(-x)$, где действительная часть $\operatorname{Re} \varepsilon(x)$ является четной функцией, а мнимая часть, описывающая усиление и поглощение среды, — нечетной функцией. Теоретически и экспериментально было показано, что в РТ-симметричных средах с усилением и поглощением могут распространяться стационарные волны с действительными волновыми векторами и постоянными амплитудами — РТсимметричные моды [8–11]. Важной характерной особенностью РТ-симметричных систем является

наличие особой точки (OT) спонтанного распада РТ-симметричного состояния, когда при определенном значении параметра усиления и поглощения происходит переход к РТ-несимметричным модам, которые при распространении в среде испытывают усиление и поглощение [5, 12, 13]. При условии спектральной сингулярности [14, 15] наблюдался лазерный эффект и идеальное когерентное поглощение [16–18]. В периодических РТ-симметричных средах, или фотонных кристаллах (ФК), исследовались РТ-симметричные эффекты, связанные с трансляционной симметрией структуры. Прежде всего — это блоховские осцилляции [19,20] и эффект однонаправленного усиленного брэгговского отражения, или однонаправленной невидимости, в особой точке спонтанного распада РТ-симметричной моды для пучков [21-25] и импульсов [26-29].

Особый интерес представляют пассивные РТсимметричные системы [12,30,31], в которых диэлектрическая проницаемость является суперпозицией РТ-симметричной функции и постоянной мнимой величины, описывающей дополнительное поглощение. В таких средах существует только поглощение, а усиление отсутствует. Однако при этом сохраняется наиболее важная и интересная особенность РТ-симметрии — наличие ОТ. Отсюда следует

^{*} E-mail: vabushuev@yandex.ru

^{**} E-mail: bmantsyzov@gmail.com

и возможность наблюдения PT-симметричных оптических эффектов, причем условия для эксперимента существенно упрощаются из-за отсутствия необходимости создания усиления в среде. Так, именно в пассивных PT-симметричных средах наблюдались спонтанный распад PT-симметричных мод [12], однонаправленное отражение [23] и асимметричная дифракция на решетке [32].

традиционных пассивных периодических B структурах, т.е. в обычных поглощающих кристаллах, хорошо известен эффект Бормана, или эффект аномально слабого поглощения рентгеновского излучения при динамической брэгговской дифракции в геометрии Лауэ (на прохождение) [33]. Суть эффекта заключается в том, что при падении излучения под углом Брэгга в совершенном кристалле распространяются две собственные моды — бормановская и антибормановская. Поле последней моды локализовано преимущественно в областях с большой электронной плотностью, и поэтому оно быстро поглощается, а поле другой моды локализовано в межатомных плоскостях с малой электронной плотностью и поглощается слабо. Оптический эффект Бормана [34] наблюдался и в обычных поглощающих ФК [35], тогда как в пассивных РТ-симметричных ФК он ещё не исследовался.

В настоящей работе теоретически рассмотрены оптические эффекты, возникающие при распространении излучения в одномерном пассивном РТсимметричном ФК в условиях динамической брэгговской дифракции в геометрии Лауэ. С помощью спектрального метода показано, что для оптического пучка в пассивном РТ-симметричном ФК вблизи ОТ наблюдается асимметричный эффект Бормана. Обсуждаются основные особенности эффекта по сравнению со случаем обыкновенного поглощающего ФК. Показано, что из-за наличия ОТ в пассивном РТ-симметричном ФК в эффекте Бормана наблюдается увеличение пропускания в направлении дифрагированной волны за счет роста поглощения среды. При этом пропускание увеличивается при положительном угле падения и уменьшается в случае отрицательного угла. Подобное асимметричное усиление эффекта Бормана имеет место и в диспергирующей среде, несмотря на нарушение строгих условий ОТ и РТ-симметрии в случае отстройки частоты излучения от резонансного брэгговского значения или при изменении угла падения. Это происходит при выполнении описанного в работах [26–29] условия широкополосной ОТ, когда спектральная область селективного брэгговского отражения существенно уже, чем ширина линии неоднородного уширения в резонансной среде.

2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО ПУЧКА В ПАССИВНОМ КВАЗИ-РТ-СИММЕТРИЧНОМ ФОТОННОМ КРИСТАЛЛЕ

Рассмотрим взаимодействие *s*-поляризованного оптического пучка

$$E_{in}(\mathbf{r},t) = A_{in}(\mathbf{r}) \exp(i\mathbf{k}_0 \cdot \mathbf{r} - i\omega t)$$
(1)

с медленно изменяющейся гауссовской амплитудой (на поверхности кристалла z = 0)

$$A_{in}(x,0) = A \exp\left[-(x\cos\theta/r_0)^2\right] \tag{2}$$

с пассивным, т. е. поглощающим, РТ-симметричным одномерным ФК при условии брэгговской дифракции в геометрии Лауэ (рис. 1). Здесь θ — угол падения излучения на поверхность z = 0, $\mathbf{k}_0 = (k_{0x}, k_{0z})$ — центральный волновой вектор в вакууме, $k_{0x} = k \sin \theta$, $k_{0z} = k \cos \theta$, $k = \omega/c = 2\pi/\lambda$, ω — частота пучка, c и λ — соответственно скорость света и длина волны в вакууме, r_0 — поперечная пирина падающего пучка.



Рис. 1. Схематическое представление двух случаев падения излучения на ΦK : (*a*) $\theta > 0$ и (*б*) $\theta < 0$; *T* и *R* — соответственно прямой проходящий и дифрагированный пучки

Диэлектрическая проницаемость структуры с учетом материальной частотной дисперсии задается следующим образом:

$$\varepsilon(x,\omega) = \varepsilon_0 + \varepsilon' \cos(hx) + \varepsilon_{res}(x,\omega), \qquad (3)$$

где $h = 2\pi/d$ — модуль вектора обратной решетки **h**, который направлен вдоль оси x, d — период решетки. Первые два слагаемых $\varepsilon_0 + \varepsilon' \cos(hx) > 1$ в выражении (3) описывают периодически модулированную четную функцию действительной части диэлектрической проницаемости, которая задается прозрачной диэлектрической средой с пренебрежимо малой материальной дисперсией, $\varepsilon' > 0$. Третье комплексное слагаемое в (3) соответствует вкладу в диэлектрическую проницаемость резонансных двухуровневых осцилляторов:

$$\varepsilon_{res}(x,\omega) = \tilde{\varepsilon}(\omega) \left[1 + \sin(hx) \right], \tag{4}$$

где величина $\tilde{\varepsilon}$ для квантовых двухуровневых осцилляторов в приближении некогерентного взаимодействия определяется следующей комплексной функцией [36]:

$$\tilde{\varepsilon}(\omega) = \beta \int_{-\infty}^{\infty} \frac{g(\omega_0 - \omega'_0)}{(\omega - \omega'_0) + i/T_2} d(\omega - \omega'_0) =$$
$$= \tilde{\varepsilon}'(\omega) + i\tilde{\varepsilon}''(\omega). \quad (5)$$

Здесь

$$\tilde{\varepsilon}'(\omega) \equiv \operatorname{Re}\tilde{\varepsilon}(\omega) = \beta \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(\omega_0' - \omega)g(\omega_0 - \omega_0')}{(\omega_0' - \omega)^2 + (\gamma_2/2)^2} d\omega_0',$$

$$\tilde{\varepsilon}''(\omega) \equiv \operatorname{Im}\tilde{\varepsilon}(\omega) = \beta \int_{-\infty}^{\infty} \frac{(\gamma_2/2)g(\omega_0 - \omega_0')}{(\omega_0' - \omega)^2 + (\gamma_2/2)^2} d\omega_0',$$
(6)

 $\beta = 4\pi (-w) N_0 \mu^2 / \hbar$, N_0 — средняя концентрация резонансных атомов, μ — величина дипольного момента перехода атома, w = -1 — инверсия невозбужденных резонансных атомов, $\omega - \omega'_0$ — отклонение частоты падающего излучения ω от частоты резонансных атомов $\omega_0', g(\omega_0 - \omega_0') - функ$ ция неоднородного уширения спектральной линии с характерной шириной γ_2^*, ω_0 — центральная частота резонанса, $\gamma_2 = 2/T_2$ — ширина однородно уширенной спектральной линии, T_2 — время поперечной однородной релаксации дипольного момента. Функция $1 + \sin(hx)$ в (4) задает пространственно-периодическое распределение концентрации $N_0[1+\sin(hx)]$ невозбужденных резонансных атомов. Формулы (5) и (6) являются квантовым аналогом формулы Лоренца-Лоренца для классического резонансного диполя. С учетом (4) формулу (3) перепишем в виде

$$\varepsilon(x,\omega) = \varepsilon_0 + \varepsilon' \cos(hx) + \tilde{\varepsilon}(\omega) \left[1 + \sin(hx)\right].$$
(7)

Мнимая часть функции $\tilde{\varepsilon}(\omega)$ в (4) и (7) задает величину поглощения излучения в среде. Условия $\tilde{\varepsilon}''(\omega) > 0$ и $1 + \sin(hx) > 0$ в (7) означают, что среда является пассивной, т. е. только поглощающей, усиление в среде отсутствует. С другой стороны, диэлектрическую проницаемость (7) можно записать в виде суперпозиции пространственно-однородной функции

$$\tilde{\varepsilon}_0(\omega) = \varepsilon_0 + \tilde{\varepsilon}(\omega)$$

и двух периодических функций, которые являются квази-РТ-симметричной частью функции $\varepsilon(x, \omega)$ (3) в случае неоднородно уширенной резонансной спектральной линии [26,27]:

$$\varepsilon(x,\omega) = \tilde{\varepsilon}_0(\omega) + \varepsilon' \cos(hx) + \tilde{\varepsilon}(\omega) \sin(hx), \qquad (8)$$

или, иначе, —

$$\varepsilon(x,\omega) = \tilde{\varepsilon}_0(\omega) + \varepsilon_1(\omega)e^{-ihx} + \varepsilon_{-1}(\omega)e^{ihx},$$

где

$$\varepsilon_1(\omega) = \frac{1}{2} \left[\varepsilon' + i\tilde{\varepsilon}(\omega) \right], \quad \varepsilon_{-1}(\omega) = \frac{1}{2} \left[\varepsilon' - i\tilde{\varepsilon}(\omega) \right]$$
(9)

— коэффициенты Фурье.

Величина поля в пучке

$$E(\mathbf{r},t) = E(x,z)\exp(-i\omega t)$$

в диспергирующей среде удовлетворяет уравнению Гельмгольца:

$$\Delta E(x,z) + k^2 \varepsilon(x,\omega) E(x,z) = 0, \qquad (10)$$

где $\Delta = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial z^2$ — оператор Лапласа.

В периодической среде вблизи условия Брэгга $2k\sin\theta_B = sh$, где θ_B — угол Брэгга, имеет место двухволновое приближение брэгговской дифракции [34]. Тогда поле в среде может быть представлено в виде суммы двух сильно связанных волн — прямой проходящей, $E_0(x, z)$, и дифракционно отраженной, $E_h(x, z)$, волн:

 $E(x, z) = E_0(x, z) + E_h(x, z),$

(11)

где

$$E_g(x,z) = \int_{-\infty}^{\infty} A_g(K) \exp[i(q_{0x} - sg)x + iq_{0z}z] \, dK.$$
(12)

Здесь g = 0, h; s = 1, если $\theta > 0,$ и s = -1,если $\theta < 0$ (рис. 1), $K = k_x - k_{0x}, A_0(K)$ и $A_h(K)$ — комплексные амплитуды спектральных компонент прямой проходящей и дифрагированной волн соответственно. Благодаря сохранению тангенциальных компонент волновых векторов на границе z = 0, x-проекция волновых векторов прямых проходящих волн в среде запишется в виде $q_{0x}(K) = k_x = k_{0x} + K.$ Из требования существования нетривиальных решений для полей (11), после их подстановки в уравнение (10), получим следующие дисперсионные уравнения для *z*-проекций волновых векторов прямой и дифрагированной волн двух собственных мод, так называемых бормановской, $q_{0z}^{(1)}$, и антибормановской, $q_{0z}^{(2)}$, мод в пассивном квази-РТсимметричном ФК:

$$q_{0z}^{(1,2)} = k \left[\tilde{\varepsilon}_0 - (q_{0x}/k)^2 + \alpha_s \mp (\alpha_s^2 + \varepsilon_1 \varepsilon_{-1})^{1/2} \right]^{1/2},$$
(13)

где параметр

$$\alpha_s = \frac{(sq_{0x} - h/2)h}{k^2} \tag{14}$$

определяет степень отклонения от точного условия Брэгга $q_{0x} = sh/2$. Из (13) и (9) следует, что в случае точного резонанса $\omega = \omega_0$ и брэгговского условия $\alpha_s = 0$ величина

$$(\varepsilon_1 \varepsilon_{-1})^{1/2} = \frac{1}{2} (\varepsilon'^2 - \tilde{\varepsilon}''^2)^{1/2}$$

определяет точку бифуркации $\tilde{\varepsilon}'' = \varepsilon'$ мнимой части (13) (см. ниже рис. 4*a*), или ОТ нарушения РТсимметрии в пассивных РТ-симметричных ФК.

Из условий непрерывности *х*-проекций векторов электрического и магнитного полей на границе z = 0несложно при условии слабого френелевского отражения получить амплитуды полей прямой и дифрагированной волн бормановской (j = 1) и антибормановской (j = 2) мод:

$$A_{0j}(K) = \mp \frac{r_{2,1}}{r_1 - r_2} A_{in}(K),$$

$$A_{hj}(K) = r_j A_{0j}(K).$$
(15)

Здесь

$$A_{in}(K) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} A_{in}(x,0) \exp(-iKx) dx$$

— преобразование Фурье амплитуды падающего пучка $A_{in}(x,0)$ (2),

$$r_j = \frac{\alpha_s \mp (\alpha_s^2 + \varepsilon_1 \varepsilon_{-1})^{1/2}}{\varepsilon_{-s}}$$

 парциальные амплитудные коэффициенты дифракционного отражения волн.

Из (15) несложно получить выражения для амплитуд полей A_{gj} в зависимости от знака *s* угла падения θ на границу z = 0. Амплитуды дифрагированных волн запишутся в виде

$$A_{h2}(K) = -A_{h1}(K) = \frac{\varepsilon_s}{2(\alpha_s^2 + \varepsilon_1 \varepsilon_{-1})^{1/2}} A_{in}(K).$$
(16)

Полное поле пучка в каждой точке ФК в любой момент времени задается следующим выражением:

$$E(x, z, t) = [A_0(x, z) + A_h(x, z)e^{-ishx}]e^{ik_{0x}x - i\omega t},$$
(17)

где

$$A_g(x,z) = \int_{-\infty}^{\infty} (A_{g1}e^{iq_{0z}^{(1)}z} + A_{g2}e^{iq_{0z}^{(2)}z})e^{iKx} \, dK, \quad (18)$$

g = 0, h, а амплитуды A_{gj} определяются из формул (15).

Из выражений (17) и (18) с учетом (15) несложно получить выражения для спектров прямого пропускания и дифракционного отражения на выходной границе $z = L \Phi K$ для падающих монохроматических пучков, т.е. модулей коэффициентов прохождения

$$T(\omega) = \left| \frac{A_0(L,\omega)}{A_{in}} \right| = \\ = \left| \frac{A_{01}(\omega)e^{iq_{0z}^{(1)}L} + A_{02}(\omega)e^{iq_{0z}^{(2)}L}}{A_{in}} \right|$$
(19)

и дифракционного отражения

$$R^{\pm}(\omega) = \left| \frac{A_{h}^{\pm}(L,\omega)}{A_{in}} \right| = \\ = \left| \frac{A_{h1}^{\pm}(\omega)e^{iq_{0z}^{(1)}L} + A_{h2}^{\pm}(\omega)e^{iq_{0z}^{(2)}L}}{A_{in}} \right|.$$
(20)

Здесь верхние индексы «±» соответствуют положительному и отрицательному знакам угла падения θ соответственно. Следует отметить, что величина коэффициента прохождения (19) не зависит от знака угла падения: $T(\omega) \equiv T^+(\omega) = T^-(\omega)$.

3. ЭФФЕКТ БОРМАНА В ПАССИВНОМ РТ-СИММЕТРИЧНОМ ФОТОННОМ КРИСТАЛЛЕ

Эффект Бормана есть аномально слабое поглощение излучения вблизи точного выполнения брэгговского условия при динамической брэгговской дифракции в геометрии Лауэ [37]. В традиционном поглощающем ФК, где пространственнонеоднородные распределения действительной и мнимой частей диэлектрической проницаемости описываются одинаковыми функциями, например, $\cos(hx)$:

$$\varepsilon(x,\omega) = \varepsilon_0 + \varepsilon' \cos(hx) + \tilde{\varepsilon}(\omega) [1 + \cos(hx)], \quad (21)$$

эффект Бормана объясняется слабым поглощением бормановской моды, поле которой локализуется преимущественно в областях с малым поглощением. В этом случае проходящее излучение уменьшается с увеличением поглощения, а также наблюдается симметрия эффекта Бормана при смене знака угла падения θ [37].

Рассмотрим эффект Бормана в пассивном РТсимметричном ФК. Покажем, что, в отличие от традиционного поглощающего ФК, в пассивной РТсимметричной структуре, во-первых, наблюдается асимметрия эффекта Бормана при смене знака угла падения и, во-вторых, амплитуда дифрагированного поля растет при увеличении резонансного поглощения среды в случае положительного угла падения.

В качестве характеристики величины поглощения в среде введем такой параметр, как $\sigma = \tilde{\varepsilon}''(\omega_0)/\varepsilon'$, т.е. отношение максимума мнимой части резонансной диэлектрической проницаемости $\tilde{\varepsilon}(\omega)$ в (8) к величине ε' , которая характеризует глубину периодической модуляции действительной части $\varepsilon(x,\omega)$. Тогда условие ОТ запишется как $\sigma = 1$. На рис. 2 представлены графики зависимостей коэффициентов дифракционного отражения R^{\pm} (20) и прохождения T (19) в центре пучка от отстройки $\Delta \theta = \theta - \theta_B$ угла падения от точного брэгговского угла при различных знаках угла θ и значениях параметра поглощения σ . Как видно из рис. 2a, при положительном угле $\theta > 0$ максимумы полей прямой и дифрагированной волн, Т и R^+ , соответствуют точному выполнению условия Брэгга $\Delta \theta = 0$, а коэффициент дифракционного отражения R^+ при $\sigma = 1.1$ (кривая 1) меньше величины R^+ при $\sigma = 2.0$ (кривая 2). Таким образом, в эффекте Бормана в пассивном РТ-симметричном ΦK при $\theta > 0$ наблюдается увеличение амплитуды поля дифрагированной волны при увеличении параметра поглощения среды σ . Ниже будет показано, что эта закономерность появляется в окрестности ОТ при $\sigma \ge 1$. Кроме того, графики на рис. 2 демонстрируют асимметрию эффекта Бормана по отношению к смене знака угла падения. Смена знака угла ($\theta > 0$ на $\theta < 0$) приводит к увеличению дифракционного отражения, $R^- > R^+$, что четко видно из сравнения кривых 1 и 2 для R^- на рис. 26 с одноименными кривыми для R^+ на рис. 2a. Кроме того, величина R^- уменьшается с ростом параметра поглощения σ (см. кривые 1 и 2 на рис. 2δ), подобно случаю традиционного поглощающего ФК. Из рис. 2 также видно, что модуль амплитуды проходящего поля Т не зависит от знака угла падения и уменьшается с увеличением параметра поглощения σ (кривые 3 и 4).



Рис. 2. а) Угловые зависимости при $\theta > 0$ коэффициентов дифракционного отражения R^+ при $\sigma = 1.1$ (кривая 1) и $\sigma = 2.0$ (кривая 2) и прохождения T при $\sigma = 1.1$ (кривая 3) и $\sigma = 2.0$ (кривая 4) от отстройки $\Delta \theta = \theta - \theta_B$ угла падения от брэгговского значения. 6) Зависимости $R^-(\Delta \theta)$ (кривые 1 и 2) и $T(\Delta \theta)$ (кривые 3 и 4) при $\theta < 0$. Параметры поглощения: $\sigma = 1.1$ (кривые 1 и 3) и $\sigma = 2.0$ (кривые 2 и 4). Толщина ФК L = 0.26 мм, $\lambda = 0.8$ мкм, $\omega = \omega_0$, d = 0.8 мкм, $\theta_B = 30^\circ$, $\varepsilon_0 = 1.3$, $\varepsilon' = 0.001$, $r_0 = 200$ мкм

Расчеты пространственного распределения амплитуд полей в ФК (18) при используемых ниже параметрах излучения и фотонного кристалла показывают, что для анализа и выявления основных особенностей распространения и дифракции пучка можно ограничиться рассмотрением плосковолнового случая при поперечном размере падающего пучка $r_0 \ge (2 \div 3)L \sin \theta_B$.

Известно [38], что в случае значительной частотной дисперсии, условие РТ-симметрии нарушается при отстройке $\Omega = \omega - \omega_0$ частоты излучения ω от точного значения резонансной частоты ω_0 . Поэтому важно ответить на вопрос: сохранятся ли особенности эффекта Бормана в пассивной PT-симметричной среде, описанные выше, в частотных спектрах отражения $R^{\mp}(\Omega)$ (20) и прохождения $T(\Omega)$ (19)? Из рис. 3 видно, что основные закономерности эффекта Бормана сохраняются при выполнении условия широкополосной ОТ [26,29], когда ширина брэгговской кривой отражения $\Delta\Omega$ существенно меньше ширины линии неоднородного уширения: $\Delta\Omega/\gamma_2^* \ll 1$.



Рис. 3. а) Спектры отражения $R^-(\Omega)$ при $\sigma>1:$ $\sigma=1.1$ и 2.0 (кривые 1 и 2), $R^+(\Omega)$ при $\sigma=1.1$ и 2.0 (кривые 3 и 4), и прохождения $T(\Omega)$ при $\sigma=1.1$ и $\sigma=2.0$ (кривые 5 и 6) при различных знаках угла $\theta_B.$ б) Спектры отражения $R^-(\Omega)$ при $\sigma<1:$ $\sigma=0.3$ и 0.9 (кривые 1 и 2), $R^+(\Omega)$ при $\sigma=0.3$ и 0.9 (кривые 3 и 4), и прохождения $T(\Omega)$ при $\sigma=0.3$ и 0.9 (кривые 5 и 6) при различных знаках угла $\theta_B.$ Расчеты выполнены в условиях широкополосной ОТ: $\gamma_2/\omega_0=0.005,$ $\gamma_2^*/\omega_0=0.1\gg\Delta\Omega/\omega_0.$ Форма линии $g(\omega_0-\omega_0')$ — гауссова. Остальные параметры такие же, как в подписи к рис. 2

Действительно, выше ОТ спонтанного распада РТ-симметричных мод, $\sigma > 1$, рис. 3a, наблюдается асимметрия спектра отражения $R^{\mp}(\Omega)$ при смене знака угла падения: $R^{-}(\Omega) > R^{+}(\Omega)$ — кривые 1, 2 для $R^{-}(\Omega)$ и 3, 4 для $R^{+}(\Omega)$. Также в случае $\theta > 0$ наблюдается увеличение коэффициента дифракционного отражения при усилении поглощения σ: $R^+(\sigma = 1.1) < R^+(\sigma = 2)$ (кривые 3 и 4). В области существования РТ-симметричных мод, т.е. ниже ОТ при $\sigma < 1$, рис. 36, величины $R^{\mp}(\Omega)$ всегда, т.е. при любом знаке угла θ , уменьшаются с увеличением поглощения σ (кривые 1, 2 и 3, 4). Независимо от знака угла падения коэффициенты прохождения $T(\Omega)$ уменьшаются при увеличении поглощения σ в обоих случаях — как выше (рис. 3a), так и ниже (рис. 3б) ОТ (кривые 5 и 6). Особенность хода кривой 5 на рис. 36 — наличие минимума при точном выполнении условия Брэгга $\Omega = 0$ — связана с маятниковым эффектом [39], т.е. периодической перекачкой энергии прямых волн бормановской и антибормановской мод в дифрагированные волны и обратно по мере распространения излучения вдоль оси z. Маятниковый эффект существует ниже ОТ при $\sigma < 1$ из-за ортогональности бормановской и антибормановской мод, $\operatorname{Re} q_{0z}^{(1)} \neq \operatorname{Re} q_{0z}^{(2)}$ (13), и отсутствует выше ОТ при $\sigma > 1$.

4. УСИЛЕНИЕ БРЭГГОВСКОЙ ДИФРАКЦИИ ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ПОГЛОЩЕНИЯ В ПАССИВНОМ РТ-СИММЕТРИЧНОМ ФОТОННОМ КРИСТАЛЛЕ

Для наглядного объяснения полученных выше закономерностей в эффекте Бормана в пассивной РТ-симметричной среде — асимметрии дифракционного отражения при смене знака угла падения и роста амплитуды дифрагированного поля при увеличении параметра поглощения среды — рассмотрим простой частный случай. Пусть в среде точно выполняются условие Брэгга $\alpha_s = 0$ и условие резонанса $\omega = \omega_0$, т. е. $\tilde{\varepsilon}'(\omega_0) = 0$ (см. (6)). Коэффициенты поглощения бормановской и антибормановской мод определяются мнимыми частями констант распространения Im $q_{0z}^{(1,2)}$ (13). Тогда из (13) при $\sigma < 1$ получим, что

$$\operatorname{Im} q_{0z}^{(1,2)} = \frac{k}{2\gamma_0} \,\varepsilon' \sigma, \qquad (22a)$$

а при
$$\sigma \ge 1$$
 —
 $\operatorname{Im} q_{0z}^{(1,2)} = \frac{k}{2\gamma_0} \varepsilon' \left[\sigma \mp \frac{1}{2} \sqrt{\sigma^2 - 1} \right],$ (22b)

где $\gamma_0^2 = \varepsilon_0 - (q_{0x}/k)^2$. Из графиков, построенных на основе этих формул на рис. 4*a*, видно, что в слу-

3 ЖЭТФ, вып. 3 (9)

чае относительно слабого поглощения, $\sigma < 1$, величина $\operatorname{Im} q_{0z}^{(1,2)}(\sigma)$ и, следовательно, поглощение среды линейно возрастают с увеличением σ . Проявление этого роста поглощения наблюдается также и в уменьшении коэффициентов отражения $R^{\mp}(\Omega)$ на графиках рис. 36 (кривые 1, 2 и 3, 4). В особой точке $\sigma = 1$ происходит распад РТ-симметричной части решения и бифуркация кривой $\operatorname{Im} q_{0z}^{(1,2)}(\sigma)$ (рис. 4a). При $\sigma > 1$ бормановская мода поглощается слабее (кривая 1), чем антибормановская (кривая 2). Более того, в некотором интервале значений σ выше ОТ на кривой 1 для бормановской моды наблюдается минимум. Качественно различное поглощение бормановской и антибормановской мод совпадает с эффектом Бормана в обычном поглощающем ФК [34,35] (см. рис. 4*б*, кривая 3).



Рис. 4. а) Графики зависимостей $\operatorname{Im} q_{0z}^{(1,2)}(\sigma)$ для бормановской (кривая 1) и антибормановской (кривая 2) мод. 6) Зависимости коэффициентов дифракционного отражения при различных знаках угла падения излучения для пассивного РТ-симметричного ФК $R^{\mp}(\sigma)$ (кривые 1 и 2) и для традиционного ФК $R_o(\sigma)$ (кривая 3) от параметра поглощения σ . в) Зависимости отношений коэффициентов отражения R^-/R_o (кривая 1) и R^+/R_o (кривая 2) от σ . r) Зависимости коэффициентов прохождения для пассивного РТ-симметричного ФК $T^+(\sigma) = T^-(\sigma)$ (кривая 1), а также для традиционного ФК $T_o(\sigma)$ (штриховая кривая 2). Толщина ФК $L = L_{EP} = 0.26$ мм, остальные параметры такие же, как в подписи к рис. 2

Однако основной особенностью брэгговской дифракции в геометрии Лауэ в РТ-симметричном ФК является асимметрия отклика среды при смене знака угла падения излучения на структуру [26,27,29]. Это приводит не только к асимметрии дифракционного отражения $R^+ \neq R^-$, но и к увеличению коэффициента отражения $R^+(\sigma)$ при росте поглощения. Изменение амплитуд дифрагированных волн $A_{h1,2}$ при смене знака брэгговского угла θ_B происходит из-за изменения величины коэффициентов Фурье ε_s в (16) при $s = +1 \leftrightarrow -1$. В случае пассивного РТсимметричного ФК зависимости амплитуд дифрагированных волн $R^+(\sigma)$ и $R^-(\sigma)$ от параметра поглощения σ различаются. Действительно, из (16) следует, что при $\theta_B > 0$

$$A_{h1}^{+} = -A_{h2}^{+} = -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1-\sigma}{1+\sigma}},$$
(23)

а в случа
е $\theta_B < 0$

$$A_{h1}^{-} = -A_{h2}^{-} = -\frac{1}{2}\sqrt{\frac{1+\sigma}{1-\sigma}}.$$
 (24)

Здесь $A_{in} = 1.$

Как видно из (23), в особой точке спонтанного распада РТ-симметричной части решения, т.е. при $\sigma = 1$, модули амплитуд $A_{h1,2}^+$ равны нулю и далее возрастают при увеличении поглощения $\sigma > 1$, т.е. выше порога ОТ. Поэтому можно ожидать, что и коэффициент дифракционного отражения R^+ будет возрастать при увеличении поглощения σ в окрестности ОТ, что соответствует рис. 2a (кривые 1 и 2) и рис. 3a (кривые 3 и 4). Амплитуды $A_{h1,2}^-$ (24) стремятся к бесконечности в ОТ, но с различными знаками, а затем монотонно убывают. Из соотношений (17) и (18) прямое и дифрагированное поля $E_0(z, \sigma)$ и $E_h(z, \sigma)$ в (11) при $\theta_B > 0$ запишутся в виде

$$E_0(z,\sigma) = \frac{1}{2} e^{-\mu(\sigma)z} \left[e^{\beta(\sigma)z} + e^{-\beta(\sigma)z} \right],$$

$$E_h(z,\sigma) = -\frac{i}{2} \sqrt{\frac{\sigma-1}{\sigma+1}} e^{-\mu(\sigma)z} \left[e^{\beta(\sigma)z} - e^{-\beta(\sigma)z} \right],$$
(25)

где

$$\mu(\sigma) = \frac{k\varepsilon'\sigma}{2\gamma_0}, \quad \beta(\sigma) = \frac{k\varepsilon'\sqrt{\sigma^2 - 1}}{4\gamma_0}$$
$$\gamma_0 = \sqrt{\varepsilon_0 - \sin^2\theta_B}.$$

Коэффициент поглощения удобно представить в виде $\mu(\sigma) = L_{EP}^{-1}\sigma$, где $L_{EP} = 2\gamma_0/k\varepsilon'$ — толщина структуры, равная длине поглощения в ОТ $\sigma = 1$.

На рис. 4б представлены графики зависимостей коэффициентов дифракционного отражения $R^{\mp}(\sigma)$ от параметра поглощения σ для пассивного РТсимметричного ФК (кривые 1 и 2), рассчитанные по формулам (20). Для сравнения представлен также график $R_o(\sigma)$ (кривая 3) для традиционного поглощающего ФК с диэлектрической проницаемостью $\varepsilon(x, \omega)$ (21). Из (21) следует, что в соотношениях (13), (16), (19) и (20) коэффициенты Фурье $\varepsilon_{1,-1}$ имеют следующий вид: $\varepsilon_1 = \varepsilon_{-1} = (\varepsilon'/2)(1 + i\sigma)$. Из графиков на рис. 4б видно, что при отрицательном угле падения величина $R^{-}(\sigma)$ (кривая 1) монотонно убывает с ростом поглощения аналогично случаю традиционного ФК (кривая 3), что объясняет уменьшение $R^{-}(\sigma)$ с ростом σ на рис. 26 и 3*a*. Если же $\theta_B > 0$, то коэффициент дифракционного отражения $R^{+}(\sigma)$ (кривая 2) возрастает при увеличении поглощения в области выше ОТ, $1 < \sigma < 2$. Аналогичные закономерности наблюдаются для кривых отражения при эффекте Бормана на рис. 2*a* (кривые 1 и 2) и рис. 3*a* (кривые 3 и 4). Видно, что ниже ОТ величина $R^{-}(\sigma)$ (кривая 1) убывает медленнее, чем $R_o(\sigma)$ (кривая 3).

Графики на рис. 46 показывают изменение относительных коэффициентов отражения R^{\mp}/R_o в зависимости от поглощения σ . При $\theta_B > 0$ это отношение монотонно увеличивается в области выше ОТ, тогда как при $\theta_B < 0$ оно уменьшается и стремится к единице с ростом параметра поглощения.

Зависимости коэффициентов прохождения на рис. 4г для пассивного РТ-симметричного ФК $T^+(\sigma) = T^-(\sigma)$ (кривая 1), рассчитанные по формуле (19), практически совпадают с зависимостью коэффициента прохождения для традиционного ФК $T_o(\sigma)$ (кривая 2).

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В настоящей работе аналитическим спектральным методом решена задача распространения оптического излучения в пассивном РТ-симметричном ФК в условиях динамической брэгговской дифракции в геометрии Лауэ. Показано, что в пассивном РТ-симметричном ФК наблюдается эффект Бормана — уменьшение поглощения в среде при выполнении брэгговского условия. Эффект имеет ряд специфических особенностей по сравнению со случаем традиционного поглощающего ФК. Во-первых, эффект Бормана становится асимметричным по отношению к смене знака брэгговского угла падения на структуру — эффект усиливается при отрицательном угле падения. Во-вторых, в окрестности особой точки в случае положительного угла падения наблюдается увеличение амплитуды прошедшей дифрагированной волны за счет роста поглощения среды. Полученные результаты для пассивных РТсимметричных структур имеют значительный фундаментальный интерес, поскольку открывают возможности для экспериментальных исследований новых РТ-симметричных явлений в более простых чисто поглощающих структурах. С прикладной точки зрения использование описанного асимметричного эффекта Бормана в пассивных РТ-симметричных ФК позволит предложить новые способы управления динамикой и параметрами световых пучков в структурах с решеточной дисперсией.

ЛИТЕРАТУРА

- C. M. Bender and S. Boettcher, Phys. Rev. Lett. 80, 5243 (1998).
- C. M. Bender, D. C. Brody, and H. F. Jones, Phys. Rev. Lett. 89, 270401 (2002).
- Z. Bian, L. Xiao, K. Wang et al., Phys. Rev. Res. 2, 022039(R) (2020).
- Parity-time Symmetry and Its Applications, ed. by D. Christodoulides, J. Yang, Springer Tracts Mod. Phys., Vol. 280, Springer, Singapore (2018).
- 5. M.-A. Miri and A. Alù, Science 363, eaar7709 (2019).
- А. А. Зябловский, А. П. Виноградов, А. А. Пухов и др., УФН 184, 1177 (2014).
- V. V. Konotop, J. Yang, and D. A. Zezyulin, Rev. Mod. Phys. 88, 035002 (2016).
- S. K. Moayedi and A. Rostami, Europ. Phys. J. B 36, 359 (2003).
- A. Ruschhaupt, F. Delgado, and J. G. Muga, J. Phys. A 38, L171 (2005).
- 10. R. El-Ganainy, K. G. Makris, D. N. Christodoulides et al., Opt. Lett. 32, 2632 (2007).
- C. E. Ruter, K. G. Makris, R. El-Ganainy et al., Nature Phys. 6, 192 (2010).
- A. Guo, G. J. Salamo, D. Duchesne et al., Phys. Rev. Lett. 103, 093902 (2009).
- K. H. Kim, M. S. Hwang, H. R. Kim et al., Nature Commun. 7, 13893 (2016).
- 14. A. Mostafazadeh, Phys. Rev. Lett. 102, 220402 (2009).
- 15. A. Mostafazadeh, Phys. Rev. Lett. 110, 260402 (2013).
- Y. D. Chong, L. Ge, H. Cao, and A. D. Stone, Phys. Rev. Lett. 105, 053901 (2010).
- 17. S. Longhi and L. Feng, Opt. Lett. 39, 5026 (2014).
- Z. J. Wong, Y. Xu, J. Kim et al., Nature Photon. 10, 796 (2016).
- 19. S. Longhi, Phys. Rev. Lett. 103, 123601 (2009).

- 20. Y. L. Xu, W. S. Fegadolli, L. Gan et al., Nature Commun. 7, 11319 (2016).
- M. Kulishov, J. M. Laniel, N. Bélanger et al., Opt. Express 13, 3068 (2005).
- 22. Z. Lin, H. Ramezani, T. Eichelkraut et al., Phys. Rev. Lett. 106, 213901 (2011).
- 23. L. Feng, Y. Xu, W. S. Fegadolli et al., Nature Mater.
 12, 108 (2012).
- 24. S. Longhi, Opt. Lett. 40, 5694 (2015).
- 25. F. Loran and A. Mostafazadeh, Phys. Rev. A 100, 053846 (2019).
- 26. D. M. Tsvetkov, V. A. Bushuev, V. V. Konotop, and B. I. Mantsyzov, Phys. Rev. A 98, 053844 (2018).
- 27. D. M. Tsvetkov, V. A. Bushuev, and B. I. Mantsyzov, Phys. Rev. A 99, 023846 (2019).
- 28. V. A. Bushuev, D. M. Tsvetkov, V. V. Konotop, and B. I. Mantsyzov, Opt. Lett. 44, 5667 (2019).
- 29. D. M. Tsvetkov, V. A. Bushuev, and B. I. Mantsyzov, Opt. Express 29, 10, 14548 (2021).

- 30. M. Ornigotti and A. Szameit, J. Opt. 16, 065501 (2014).
- 31. Ş. K. Özdemir, S. Rotter, F. Nori et al., Nature Mater. 18, 783 (2019).
- 32. X. Zhu, Y. Xu, Y. Zou et al., Appl. Phys. Lett. 109, 111101 (2016).
- 33. G. Borrmann, Phys. Z. 42, 157 (1941).
- 34. А. А. Скорынин, В. А. Бушуев, Б. И. Манцызов, ЖЭТФ 142, 64 (2012).
- 35. V. B. Novikov and T. V. Murzina, Opt. Lett. 42, 1389 (2017).
- 36. Л. Аллен, Дж. Эберли, Оптический резонанс и двухуровневые атомы, Мир, Москва (1978).
- **37**. A. Authier, *Dynamical Theory of X-ray Diffraction*, Oxford Univ. Press, Oxford (2004).
- 38. A. A. Zyablovsky, A. P. Vinogradov, A. V. Dorofeenko et al., Phys. Rev. A 89, 033808 (2014).
- 39. V. A. Bushuev, L. V. Dergacheva, and B. I. Mantsyzov, Phys. Rev. A 95, 033843 (2017).